



(19)中華民國智慧財產局

(12)發明說明書公告本

(11)證書號數：TW I838343 B

(45)公告日：中華民國 113 (2024) 年 04 月 11 日

(21)申請案號：107129142

(22)申請日：中華民國 107 (2018) 年 08 月 21 日

(51)Int. Cl. : C09K3/14 (2006.01)

C09G1/02 (2006.01)

B24B37/00 (2012.01)

H01L21/304 (2006.01)

(30)優先權：2017/09/21 美國

15/710898

(71)申請人：美商羅門哈斯電子材料 C M P 控股公司 (美國) ROHM AND HAAS ELECTRONIC MATERIALS CMP HOLDINGS, INC. (US)

美國

(72)發明人：夕凡奈伊甘 穆拉利 G THEIVANAYAGAM, MURALI G. (IN) ; 王 紅雨 WANG, HONGYU (US) ; 凡漢翰 馬修 VAN HANEHEM, MATTHEW (US)

(74)代理人：洪武雄；陳昭誠

(56)參考文獻：

TW 201603945A

TW 201716525A

US 2011/0318929A1

US 2013/0045599A1

審查人員：韓薰蘭

申請專利範圍項數：8 項 圖式數：0 共 22 頁

(54)名稱

用於鈷的化學機械拋光方法

(57)摘要

一種用於化學機械拋光含有鈷及 TiN 之基板以使表面平坦化並至少改善所述基板之表面形貌的方法。所述方法包含提供含有鈷及 TiN 之基板；提供拋光組合物，其含有以下各物作為初始組分：水、氧化劑、天冬胺酸或其鹽，及直徑 25 nm 之膠態二氧化矽研磨劑；且提供具有拋光表面之化學機械拋光墊；在所述拋光墊與所述基板之間的界面處建立動態接觸；並將所述拋光組合物分配至在所述拋光墊與所述基板之間界面處或附近的所述拋光表面上；其中一些所述鈷經拋光去除以使所述基板平坦化，由此提供改善的鈷:TiN 去除速率選擇性。

A process for chemical mechanical polishing a substrate containing cobalt and TiN to planarize the surface and at least improve surface topography of the substrate. The process includes providing a substrate containing cobalt and TiN; providing a polishing composition, containing, as initial components: water; an oxidizing agent; aspartic acid or salts thereof; and, colloidal silica abrasives with diameters of 25 nm; and, providing a chemical mechanical polishing pad, having a polishing surface; creating dynamic contact at an interface between the polishing pad and the substrate; and dispensing the polishing composition onto the polishing surface at or near the interface between the polishing pad and the substrate; wherein some of the cobalt is polished away to planarize the substrate to provide improved cobalt:TiN removal rate selectivity.



I838343

【發明摘要】

【中文發明名稱】用於鈷的化學機械拋光方法

【英文發明名稱】CHEMICAL MECHANICAL POLISHING METHOD FOR
COBALT

【中文】

一種用於化學機械拋光含有鈷及 TiN 之基板以使表面平坦化並至少改善所述基板之表面形貌的方法。所述方法包含提供含有鈷及 TiN 之基板；提供拋光組合物，其含有以下各物作為初始組分：水、氧化劑、天冬胺酸或其鹽，及直徑 ≤ 25 nm 之膠態二氧化矽研磨劑；且提供具有拋光表面之化學機械拋光墊；在所述拋光墊與所述基板之間的界面處建立動態接觸；並將所述拋光組合物分配至在所述拋光墊與所述基板之間界面處或附近的所述拋光表面上；其中一些所述鈷經拋光去除以使所述基板平坦化，由此提供改善的鈷:TiN 去除速率選擇性。

【英文】

A process for chemical mechanical polishing a substrate containing cobalt and TiN to planarize the surface and at least improve surface topography of the substrate. The process includes providing a substrate containing cobalt and TiN; providing a polishing composition, containing, as initial components: water; an oxidizing agent; aspartic acid or salts thereof; and, colloidal silica abrasives with diameters of ≤ 25 nm; and, providing a chemical mechanical polishing pad, having a polishing surface; creating dynamic contact at an interface between the polishing pad and the substrate; and dispensing the polishing composition onto the polishing surface at or near the

interface between the polishing pad and the substrate; wherein some of the cobalt is polished away to planarize the substrate to provide improved cobalt:TiN removal rate selectivity.

【指定代表圖】 無

【代表圖之符號簡單說明】

無

【發明說明書】

【中文發明名稱】用於鈷的化學機械拋光方法

【英文發明名稱】CHEMICAL MECHANICAL POLISHING METHOD FOR
COBALT

【技術領域】

【0001】 本發明係關於化學機械拋光鈷以至少改善鈷相對於 TiN 之去除速率選擇性的領域。更具體地說，本發明係關於一種化學機械拋光鈷以至少改善鈷相對於 TiN 的去除速率選擇性的方法，所述方法係藉由以下方式進行：提供含有鈷及 TiN 之基板；提供拋光組合物，其含有以下各物作為初始組分：水；氧化劑；天冬胺酸或其鹽；平均粒徑小於或等於 25 nm 之膠態二氧化矽研磨劑；提供具有拋光表面之化學機械拋光墊；在拋光墊與基板之間的界面處建立動態接觸；並將拋光組合物分配至在拋光墊與基板之間的界面處或附近的拋光表面上，其中一些鈷自基板拋光去除。

【先前技術】

【0002】 在製造積體電路及其他電子器件時，可以在半導體晶圓之表面上沈積或自其去除多層導電、半導體及介電材料。薄層導電、半導體及介電材料可以藉由多種沈積技術沈積。現代加工中的常見沈積技術包括物理氣相沈積（physical vapor deposition，PVD），又稱作濺射；化學氣相沈積（chemical vapor deposition，CVD）；電漿增強化學氣相沈積（plasma-enhanced chemical vapor deposition，PECVD）；及電化學電鍍（electrochemical plating，ECP）。

【0003】 隨著材料層依次沈積及去除，晶圓之最上層表面變得不平坦。因

為後續的半導體加工（例如金屬化）需要晶圓具有平坦的表面，所以需要使晶圓平坦化。平坦化可用於去除不需要的表面形貌及表面缺陷，諸如粗糙表面、聚結材料、晶格損傷、劃痕及受污染的層或材料。

【0004】化學機械平坦化或化學機械拋光（chemical mechanical polishin，CMP）係用於使基板諸如半導體晶圓平坦化的常用技術。在習知 CMP 中，晶圓安裝在載體組件上並定位成與 CMP 設備中之拋光墊接觸。載體組件向晶圓提供可控壓力，將其壓靠在拋光墊上。拋光墊在外部驅動力下相對於晶圓移動（例如旋轉）。與此同時，在晶圓與拋光墊之間提供拋光組合物（「漿料」）或其他拋光溶液。因此，藉由墊表面及漿料之化學及機械作用，晶圓表面經拋光並變得平坦。但是，CMP 中涉及很多複雜問題。每種類型之材料皆需要獨特的拋光組合物、合理設計之拋光墊、針對拋光及 CMP 後清潔兩者之最佳化製程設置、以及必須針對拋光特定材料之應用而單獨定製的其他因素。

【0005】對於 10 奈米及以下的先進技術節點，正在實施使鈷取代鎢插塞將電晶體閘極連接至後端製程（Back End of Line，BEOL）中的金屬互連件，並取代 BEOL 中前幾個金屬層之金屬線及通孔中的銅。在該等方案中，鈷將沈積在 Ti/TiN 阻擋層之頂部。所有此等新製程均需要 CMP 以實現針對所需的目標材料厚度及選擇性的平面度。

【0006】為了獲得高效的效能，CMP 工業需要鈷漿料提供 1500 Å/min 或更高的高鈷去除速率，且同時展示出低阻擋物（例如 TiN）去除速率以實現可接受之形貌控制。阻擋層將導電材料與非導電絕緣體介電材料諸如 TEOS 分開，並抑制自一層至下一層的不希望之電遷移（electro-migration）。過量去除阻擋層會引起電遷移，由此導致半導體器件功能失常。由於器件之進一步小型化不斷地驅動半導體工業改善晶片效能，各種材料之尺寸變得更小及更薄，並且半導體上之特徵變得更密集，使得 CMP 更難提供所需之金屬諸如鈷的去除速率且

同時防止阻擋層及絕緣體材料之過量去除以防止半導體器件的功能失常。

【0007】 因此，需要一種至少改善鈷:TiN 阻擋層去除速率選擇性的用於鈷之 CMP 拋光方法及組合物。

【發明內容】

【0008】 本發明提供一種化學機械拋光鈷之方法，其包括：提供包括鈷及 TiN 之基板；提供化學機械拋光組合物，其包含以下各物作為初始組分：水；氧化劑；至少 0.1 wt%-量的天冬胺酸或其鹽；平均粒徑為 25 nm 或更小的膠態二氧化矽研磨劑；以及視情況，腐蝕抑制劑；視情況，界面活性劑；視情況，殺生物劑；視情況，pH 調節劑；提供具有拋光表面之化學機械拋光墊；在化學機械拋光墊與基板之間的界面處建立動態接觸；並將化學機械拋光組合物分配至在化學機械拋光墊與基板之間的界面處或附近的化學機械拋光墊之拋光表面上；其中一些鈷自基板拋光去除。

【0009】 本發明提供一種化學機械拋光鈷之方法，其包括：提供包括鈷及 TiN 之基板；提供化學機械拋光組合物，其包含以下各物作為初始組分：水；氧化劑；0.1 wt%至 5 wt%量的天冬胺酸或其鹽；粒徑為 5 nm 至 25 nm 且具有負 ζ 電位之膠態二氧化矽研磨劑；pH 值大於 6；視情況，腐蝕抑制劑；視情況，界面活性劑；視情況，殺生物劑；以及視情況，pH 調節劑；提供具有拋光表面之化學機械拋光墊；在化學機械拋光墊與基板之間的界面處建立動態接觸；並將化學機械拋光組合物分配至在化學機械拋光墊與基板之間的界面處或附近的化學機械拋光墊之拋光表面上；其中一些鈷自基板拋光去除；其中在 200 mm 拋光機上，在壓板轉速為 93 轉/分鐘，拋光頭轉速為 87 轉/分鐘，化學機械拋光組物流動速率為 200 mL/min，標稱下壓力為 13.8 kPa 下，所提供的化學機械拋光

組合物之鈷去除速率 $\geq 1500 \text{ \AA}/\text{min}$ ；且其中所述化學機械拋光墊包括含有聚合物空心微粒及聚胺酯浸漬之非編織襯墊（subpad）的聚胺酯拋光層。

【0010】本發明提供一種化學機械拋光鈷之方法，其包括：提供包括鈷及 TiN 之基板；提供化學機械拋光組合物，其包含以下各物作為初始組分：水；0.01 wt% 至 2 wt% 之氧化劑，其中氧化劑係過氧化氫；0.1 wt% 至 3 wt% 之量的天冬胺酸或其鹽；粒徑為 10 nm 至 24nm 且具有負 ζ 電位之膠態二氧化矽研磨劑；pH 值為 7 至 9；視情況，腐蝕抑制劑，其選自由雜環氮化合物、多羧酸及其混合物組成之群；視情況，界面活性劑；視情況，殺生物劑；以及視情況，pH 調節劑；提供具有拋光表面之化學機械拋光墊；在化學機械拋光墊與基板之間的界面處建立動態接觸；並將化學機械拋光組合物分配至在化學機械拋光墊與基板之間的界面處或附近的化學機械拋光墊之拋光表面上；其中一些鈷自基板拋光去除；其中在 200mm 拋光機上，在壓板轉速為 93 轉/分鐘，拋光頭轉速為 87 轉/分鐘，化學機械拋光組物流動速率為 200 mL/min，標稱下壓力為 13.8 kPa 下，所提供的化學機械拋光組合物之鈷去除速率 $\geq 1500 \text{ \AA}/\text{min}$ ；其中所述化學機械拋光墊包括含有聚合物空心微粒及聚胺酯浸漬之非編織襯墊的聚胺酯拋光層。

【0011】本發明提供一種化學機械拋光鈷的方法，其包括：提供包括鈷及 TiN 之基板；提供化學機械拋光組合物，其包括以下各物作為初始組分：水；0.1 wt% 至 1 wt% 之氧化劑，其中氧化劑係過氧化氫；0.3 wt% 至 1 wt% 的天冬胺酸或其鹽；0.3 至 2 wt% 的平均粒徑為 20 nm 至 23 nm 且具有負 ζ 電位之膠態二氧化矽研磨劑；pH 值為 7.5 至 9；視情況，0.001 wt% 至 1 wt% 之腐蝕抑制劑，其選自由雜環氮化合物、多羧酸及其混合物組成之群；視情況，界面活性劑；視情況，pH 調節劑；視情況，殺生物劑；提供具有拋光表面之化學機械拋光墊；在化學機械拋光墊與基板之間的界面處建立動態接觸；並將化學機械拋光組合物分配至在化學機械拋光墊與基板之間的界面處或附近的化學機械拋光墊之拋光

第4頁，共 16 頁(發明說明書)

表面上；其中一些鈷自基板拋光去除。

【0012】 本發明提供一種化學機械拋光鈷的方法，其包括：提供包括鈷及 TiN 之基板；提供化學機械拋光組合物，其包括以下各物作為初始組分：水；0.1 wt% 至 0.5 wt% 之氧化劑，其中氧化劑係過氧化氫；0.3 wt% 至 1 wt% 的天冬胺酸或其鹽；0.3 wt% 至 1.5 wt% 的平均直徑為 20 nm 至 23 nm 且具有負表面電荷之膠態二氧化矽研磨劑；視情況，0.005 wt% 至 0.1 wt% 之腐蝕抑制劑，其選自由雜環氮化合物、多羧酸及其混合物組成之群，其中雜環氮化合物選自由腺嘌呤、1,2,4-三唑、咪唑、聚咪唑及其混合物組成之群，其中多羧酸選自由己二酸、馬來酸、蘋果酸、其鹽及其混合物組成之群；pH 值為 8 至 9；以及 pH 調節劑，其中 pH 調節劑係 KOH；及視情況，界面活性劑；視情況，殺生物劑；提供具有拋光表面之化學機械拋光墊；在化學機械拋光墊與基板之間的界面處建立動態接觸；並且將化學機械拋光組合物分配至在化學機械拋光墊與基板之間的界面處或附近的化學機械拋光墊之拋光表面上；其中一些鈷自基板拋光去除。

【0013】 上述本發明之方法使用化學機械拋光組合物以高拋光速率拋光鈷以除去至少一些鈷，由此提供高鈷:TiN 去除速率選擇性，所述組合物包括以下各物作為初始組分：水；至少 0.1 wt% 之量的天冬胺酸或其鹽；氧化劑；平均粒徑為 25nm 或更小的膠態二氧化矽研磨劑；以及視情況，腐蝕抑制劑；視情況，界面活性劑；及視情況，pH 調節劑；及視情況，殺生物劑。

【實施方式】

【0014】 除非上下文另有說明，否則如本說明書通篇所用，以下縮寫具有以下含義：°C =攝氏度；g =公克；L =公升；mL =毫升； μ = μm =微米；kPa =千帕；Å=埃；mV =毫伏；DI =去離子；mm=毫米；cm=公分；min =分鐘；sec =

秒；rpm =轉/分鐘；lbs=磅；kg=千克；Co =鈷；Ti =鈦；TiN =氮化鈦；H₂O₂ =過氧化氫；KOH =氫氧化鉀；wt%=重量百分比；PVD =物理氣相沈積；RR =去除速率；PS =拋光漿料；及 CS =對照漿料。

【0015】術語「化學機械拋光」或「CMP」係指僅僅藉助於化學及機械力拋光基板的工序且不同於對基板施加電偏壓之電化學機械拋光（electrochemical-mechanical polishing，ECMP）。術語「天冬胺酸」意指 α -氨基酸且可以包括 L-天冬胺酸、D-天冬胺酸或其外消旋混合物。術語「TEOS」意指由原矽酸四乙酯（Si(OC₂H₅)₄）分解形成的二氧化矽。術語「一（a/an）」係指單數及複數兩種。除非另有說明，否則所有百分比均以重量計。所有數值範圍皆包括端點在內且可以按任何順序組合，但在邏輯上，這類數值範圍係限制於總計 100%。

【0016】本發明的拋光基板之方法（其中基板包括鈷及 TiN）使用化學機械拋光組合物自基板表面除去至少一些鈷並抑制 TiN 去除速率以提供至少較高的鈷:TiN 去除速率選擇性，所述組合物含有以下各物作為初始組分：水；氧化劑；至少 0.1 wt%量的天冬胺酸或其鹽；平均粒徑小於或等於 25 nm 的膠態二氧化矽研磨劑；以及視情況，腐蝕抑制劑；視情況，界面活性劑；視情況，殺生物劑；及視情況，pH 調節劑。

【0017】較佳地，本發明的拋光基板之方法包括：提供基板，其中基板包括鈷及 TiN；提供化學機械拋光組合物，其包含以下各物作為初始組分，較佳由以下各物作為初始組分組成：水；氧化劑，較佳其量為 0.01 wt%至 2 wt%，更佳其量為 0.1 wt%至 1 wt%，甚至更佳為 0.1 wt%至 0.5 wt%；天冬胺酸或其鹽或其混合物，其量等於或大於 0.1 wt%，較佳為 0.1 wt%至 5 wt%，更佳為 0.1 wt%至 3 wt%，甚至更佳為 0.3 wt%至 1 wt%，又甚至更佳為 0.3 wt%至 0.9 wt%，且最佳地為 0.5 wt%至 0.9 wt%；平均粒徑為 25 nm 或更小的膠態二氧化矽研磨劑，

第6頁，共 16 頁(發明說明書)

較佳其量為 0.01 wt%至 5 wt%，更佳為 0.01 wt%至 3 wt%，甚至更佳地，其量為 0.3 wt%至 3 wt%，又更佳為 0.3 wt%至 2 wt%，最佳為 0.3 wt%至 1.5 wt%；以及視情況，殺生物劑；視情況，腐蝕抑制劑，較佳其量為 0.001 wt%至 1 wt%，更佳為 0.001 wt%至 0.5 wt%，甚至更佳為 0.005 wt%至 0.1 wt%；視情況，界面活性劑；及視情況，pH 調節劑；其中化學機械拋光組合物之 pH 值大於 6，較佳地為 7 至 9，更佳為 7.5 至 9，甚至更佳地為 8 至 9，最佳為 8 至 8.5；提供具有拋光表面之化學機械拋光墊；在化學機械拋光墊與基板之間的界面處建立動態接觸；並將化學機械拋光組合物分配至在化學機械拋光墊與基板之間的界面處或附近的化學機械拋光墊之拋光表面上；其中至少一些鈷自基板拋光去除。

【0018】較佳地，在本發明的拋光基板之方法中，所提供的化學機械拋光組合物中包含作為初始組分的水係去離子水及蒸餾水中之至少一種，用以限制附帶雜質。

【0019】較佳地，在本發明的拋光基板的方法中，所提供的化學機械拋光組合物含有氧化劑作為初始組分、其中氧化劑選自由以下組成之群：過氧化氫（ H_2O_2 ）、單過硫酸鹽、碘酸鹽、過鄰苯二甲酸鎂、過乙酸及其他過酸、過硫酸鹽、溴酸鹽、過溴酸鹽、過硫酸鹽、過乙酸、高碘酸鹽、硝酸鹽、鐵鹽、銻鹽、 Mn(III) 鹽、 Mn(IV) 鹽及 Mn(VI) 鹽、銀鹽、銅鹽、鉻鹽、鈷鹽、鹵素、次氯酸鹽及其混合物。更佳地，氧化劑選自由以下組成之群：過氧化氫、高氯酸鹽、過溴酸鹽、高碘酸鹽、過硫酸鹽及過乙酸。最佳地，氧化劑係過氧化氫。

【0020】較佳地，在本發明的拋光基板之方法中，所提供的化學機械拋光組合物含有 0.01 wt%至 2 wt%，更佳地 0.1 wt%至 1 wt%，甚至更佳地 0.1 wt%至 0.5 wt%，最佳地 0.2 wt%至 0.4 wt%的氧化劑作為初始組分。

【0021】較佳地，在本發明的拋光基板之方法中，所提供的化學機械拋光組合物含有至少 0.1 wt%量的天冬胺酸、天冬胺酸鹽或其混合物作為初始組分。

天冬胺酸鹽包括但不限於 L-天冬胺酸鈉鹽單水合物、L-天冬胺酸鉀鹽及 DL-天冬胺酸鉀鹽。較佳地，在本發明的拋光基板之方法中，本發明的化學機械拋光組合物中包含 L-天冬胺酸。在本發明的拋光基板之方法中，所提供的化學機械拋光組合物含有較佳地 0.1 wt%至 5 wt%，更佳 0.1 wt%至 3 wt%，甚至更佳 0.3 wt%至 1 wt%，又甚至更佳 0.3 wt%至 0.9 wt%，且最佳 0.5 wt%至 0.9 wt%的 L-天冬胺酸、D-天冬胺酸、外消旋混合物、其鹽或其混合物作為初始組分。

【0022】較佳地，在本發明的拋光基板之方法中，所提供的化學機械拋光組合物含有粒徑為 25 nm 或更小且具有負 ζ 電位之膠態二氧化矽研磨劑。更佳地，在本發明的拋光基板之方法中，所提供的化學機械拋光組合物含有平均粒徑為 25 nm 或更小且具有永久負 ζ 電位之膠態二氧化矽研磨劑，其中化學機械拋光組合物的 pH 值大於 6，較佳地為 7 至 9，更佳地為 7.5 至 9，且又更佳地為 8 至 9，最佳地為 8 至 8.5。又更佳地，在本發明的拋光基板之方法中，所提供的化學機械拋光組合物含有平均粒徑為 25 nm 或更小且具有永久負 ζ 電位之膠態二氧化矽研磨劑，其中化學機械拋光組合物的 pH 值大於 6，較佳為 7 至 9，更佳地為 7.5 至 9，又更佳地為 8 至 9，最佳為 8 至 8.5，其中 ζ 電位為 -0.1 mV 至 -35 mV。

【0023】較佳地，在本發明的拋光基板之方法中，所提供的化學機械拋光組合物含有膠態二氧化矽研磨劑作為初始組分，如藉由動態光散射技術所量測，其平均粒徑為 25 nm 或更小，較佳為 5 nm 至 25 nm，更佳地為 5 nm 至小於 25 nm，甚至更佳為 10 nm 至 24 nm，又更佳為 10 nm 至 23 nm，最佳為 20 nm 至 23 nm。適合的粒度量測儀器可以自例如 Malvern Instruments（英國馬爾文（Malvern，UK））獲得。

【0024】較佳地，與呈結合或組合球體形式的繭狀膠態二氧化矽研磨劑相比，膠態二氧化矽研磨劑係球形的。球形膠態二氧化矽顆粒並非結合的球體。球形膠態二氧化矽顆粒之尺寸係藉由顆粒之直徑度量。相比之下，呈結合球體

形式之繭狀顆粒的尺寸係包圍顆粒之最小球體的直徑及顆粒的長度。可商購的球形膠態二氧化矽顆粒之實例係購自 Fuso Chemical Co., LTD 的 Fuso PL-2L (平均粒徑為 23nm) 及購自 Merck KGaA 之 EMD Performance Materials 的 K1598-B-12 (平均粒徑為 20 nm)。可商購的繭狀膠態二氧化矽顆粒之實例係 Fuso SH-3 (53 nm 平均粒徑之膠態二氧化矽顆粒形成平均長度為 70 nm 的結合球體) 及 Fuso PL-2 (37 nm 平均粒徑之膠態二氧化矽顆粒形成平均長度為 70 nm 的結合球體)，該兩種亦可自 Fuso Chemical Co., LTD 購得。

【0025】較佳地，在本發明的拋光基板之方法中，所提供的化學機械拋光組合物含有較佳地 0.01 wt% 至 5 wt%，更佳 0.01 wt% 至 3 wt% 之量，甚至更佳地 0.3 wt% 至 3 wt%，又更佳地 0.3 wt% 至 2 wt%，最佳 0.3 wt% 至 1.5 wt% 之量的膠態二氧化矽研磨劑作為初始組分，如藉由動態光散射技術所量測，其粒徑小於或等於 25 nm，較佳地為 5 nm 至 25 nm，更佳地為 5 nm 至小於 25 nm，甚至更佳為 10 nm 至 24 nm，又更佳為 10 nm 至 23 nm，最佳為 20 nm 至 23 nm。較佳地，膠態二氧化矽研磨劑具有永久負 ζ 電位。

【0026】視情況，在本發明的拋光基板之方法中，所提供的化學機械拋光組合物含有腐蝕抑制劑作為初始組分，其中所述腐蝕抑制劑選自由雜環氮化合物、非芳族多羧酸及其混合物組成之群，其中雜環氮化合物選自由腺嘌呤、1,2,4-三唑、咪唑、聚咪唑及其混合物組成之群；且其中非芳族多羧酸包含但不限於草酸、琥珀酸、己二酸、馬來酸、蘋果酸、戊二酸、檸檬酸、其鹽或其混合物。較佳地，前述非芳族多羧酸之鹽選自鈉、鉀及銨鹽中之一種或多種。當在本發明的化學機械拋光基板之方法中化學機械拋光組合物包含雜環氮化合物時，較佳地，作為初始組分，雜環氮化合物係腺嘌呤。當在本發明的拋光基板之方法中化學機械拋光組合物包含非芳族多羧酸時，所提供的化學機械拋光組合物較佳地含有選自由蘋果酸、草酸、己二酸、檸檬酸、其鹽及其混合物組成之群的

非芳族多羧酸作為初始組分。更佳地，當所提供的化學機械拋光組合物含有非芳族多羧酸作為初始組分時，非芳族多羧酸選自由蘋果酸、檸檬酸、己二酸、其鹽及其混合物組成之群。最佳地，在本發明的拋光基板之方法中，當所提供的化學機械拋光組合物含有非芳族多羧酸作為初始組分時，非芳族多羧酸係非芳族二羧酸己二酸或其鹽，其中較佳地，所述鹽選自由己二酸鈉、己二酸鉀及己二酸銨組成之群。

【0027】 當在本發明的拋光基板之方法中包含腐蝕抑制劑時，所提供的化學機械拋光組合物含有 0.001 wt% 至 1 wt%，更佳 0.001 wt% 至 0.5 wt%，甚至更佳 0.005 wt% 至 0.1 wt% 的選自由雜環氮化合物、非芳族多羧酸及其混合物組成之群之腐蝕抑制劑作為初始組分，其中雜環氮化合物選自由腺嘌呤、1,2,4-三唑、咪唑、聚咪唑及其混合物組成之群；且其中非芳族多羧酸選自由草酸、琥珀酸、己二酸、馬來酸、蘋果酸、戊二酸、檸檬酸、其鹽及其混合物組成之群。較佳地，在本發明的拋光基板之方法中，所提供的化學機械拋光組合物含有 0.001 至 1 wt%，更佳 0.001 至 0.5 wt%，甚至更佳 0.005 wt% 至 0.1 wt%，最佳 0.01 至 0.1 wt% 的雜環氮化合物腺嘌呤；及二羧酸己二酸、己二酸鹽或其混合物作為初始組分，其中所述鹽較佳地選自由己二酸鈉、己二酸鉀及己二酸銨。

【0028】 最佳地，當在本發明的化學機械拋光基板之方法中包含腐蝕抑制劑時，化學機械拋光組合物包含非芳族多羧酸或其鹽作為初始組分，其中非芳族多羧酸或其鹽係選自由己二酸、己二酸鹽、蘋果酸、蘋果酸鹽、馬來酸、馬來酸鹽及其混合物組成之群的非芳族二羧酸或其鹽；且最佳地，除腺嘌呤外，其中化學機械拋光組合物不含唑類腐蝕抑制劑及唑類腐蝕抑制劑的衍生物，以及雜環氮化合物類腐蝕抑制劑。

【0029】 在本發明的拋光基板之方法中，所提供的化學機械拋光組合物之 pH 值大於 6。較佳地，在本發明的拋光基板之方法中，所提供的化學機械拋光

組合物之 pH 值為 7 至 9；更佳地，在本發明的拋光基板之方法中，所提供的化學機械拋光組合物之 pH 值為 7.5 至 9。甚至更佳地，在本發明的拋光基板之方法中，所提供的化學機械拋光組合物之 pH 值為 8 至 9，最佳地，所提供的化學機械拋光組合物之 pH 值為 8 至 8.5。

【0030】較佳地，在本發明的拋光基板之方法中，所提供的化學機械拋光組合物視情況含有 pH 調節劑。較佳地，pH 調節劑選自由無機及有機 pH 調節劑組成之群。較佳地，pH 調節劑選自由無機酸及無機鹼組成之群。更佳地，pH 調節劑選自由硝酸及氫氧化鉀組成之群。最佳地，pH 調節劑係氫氧化鉀。

【0031】視情況，在本發明之方法中，化學機械拋光組合物含有殺生物劑，諸如 KORDEX™ MLX（9.5-9.9% 甲基-4-異噻唑啉-3-酮、89.1-89.5% 水及 ≤1.0% 相關反應產物）或含有活性成分 2-甲基-4-異噻唑啉-3-酮及 5-氯-2-甲基-4-異噻唑啉-3-酮的 KATHON™ ICPIII，各自由 The Dow Chemical Company 製造（KATHON 及 KORDEX 係 The Dow Chemical Company 之商標）。

【0032】在本發明的拋光基板之方法中，視情況，所提供的化學機械拋光組合物含有 0.001 wt% 至 0.1 wt%，較佳地 0.001 wt% 至 0.05 wt%，更佳 0.01 wt% 至 0.05 wt%，又更佳 0.01 wt% 至 0.025 wt% 的殺生物劑作為初始組分。

【0033】視情況，在本發明之方法中，化學機械拋光組合物亦可包含消泡劑，諸如非離子界面活性劑，包含酯、環氧乙烷、醇、乙氧基化物、矽化合物、氟化合物、醚、糖苷及其衍生物。陰離子醚硫酸鹽諸如十二烷基醚硫酸鈉（SLES）以及鉀鹽及銨鹽。界面活性劑亦可為兩性界面活性劑。

【0034】在本發明的拋光基板之方法中，視情況，所提供的化學機械拋光組合物可含有 0.001 wt% 至 0.1 wt%，較佳地 0.001 wt% 至 0.05 wt%，更佳 0.01 wt% 至 0.05 wt%，又更佳 0.01 wt% 至 0.025 wt% 的界面活性劑作為初始組分。

【0035】較佳地，在本發明的拋光基板之方法中，所提供的化學機械拋光

墊可以為此項技術中已知的任何合適之拋光墊。一般熟習此項技術者知道選擇用於本發明之方法中的合適之化學機械拋光墊。更佳地，在本發明的拋光基板之方法中，所提供的化學機械拋光墊選自編織及非編織拋光墊。又更佳地，在本發明的拋光基板之方法中，所提供的化學機械拋光墊包括聚胺酯拋光層。最佳地，在本發明的拋光基板之方法中，所提供的化學機械拋光墊包括含聚合物空芯微粒及聚胺酯浸漬之非編織襯墊的聚胺酯拋光層。較佳地，所提供的化學機械拋光墊在拋光表面上具有至少一個槽。

【0036】較佳地，在本發明的拋光基板之方法中，將所提供的化學機械拋光組合物分配至在化學機械拋光墊與基板之間的界面處或附近的化學機械拋光墊之拋光表面上。

【0037】較佳地，在本發明的拋光基板之方法中，在所提供的化學機械拋光墊與基板之間的界面處建立動態接觸，其中垂直於經拋光基板之表面的下壓力為 0.69 至 34.5 kPa。

【0038】在本發明的拋光基板之方法中，所提供的化學機械拋光組合物之鈷去除速率 $\geq 1500 \text{ \AA}/\text{min}$ ，較佳地 $\geq 1800 \text{ \AA}/\text{min}$ ，更佳地 $\geq 1900 \text{ \AA}/\text{min}$ ，又更佳地 $\geq 2200 \text{ \AA}/\text{min}$ ，甚至更佳地 $\geq 2300 \text{ \AA}/\text{min}$ ；且 Co:TiN 選擇性 $\geq 30:1$ ，較佳地，Co:TiN 選擇性 $\geq 31:1$ ，更佳地，Co:TiN 選擇性 $\geq 34:1$ ，又更佳地，Co:TiN 選擇性 $\geq 40:1$ ；最佳地，Co:TiN 選擇性 $\geq 50:1$ ；且其中 Co:TiN 選擇性之更佳範圍為 31:1 至 55:1；且在 200 mm 拋光機上，壓板轉速為 93 轉/分鐘，拋光頭轉速為 87 轉/分鐘，化學機械拋光組物流動速率為 200 mL/min，標稱下壓力為 13.8 kPa；且其中化學機械拋光墊包括含有聚合物中空芯微粒及聚胺酯浸漬之非編織襯墊的聚胺酯拋光層。

【0039】以下實例旨在說明本發明之一個或多個實施例的 Co:TiN 之去除速率選擇性，但不旨在限制其範圍。

實例 1

漿料配製物

【0040】 表 1 及 2 用於拋光研究的所有漿料係如以下程序中所述製備。將 L-天冬胺酸、己二酸、腺嘌呤及 KORDEK™ MLX 加入去離子水中並使用頂置式攪拌器（300-450 RPM）混合直至完全溶解，得到最終 L-天冬胺酸濃度為 0.9 wt% 或 0.5 wt%，最終己二酸濃度為 0.1 wt%，最終腺嘌呤濃度為 0.05 wt%，最終 KORDEK™ MLX 濃度為 0.005 wt%，隨後用稀 KOH 溶液（5% 或 45%）將 pH 值調至 pH 值大於 7。自 Fuso chemical Co., LTD 獲得以下膠態二氧化矽顆粒：Fuso PL-2L（23 nm 平均直徑之球形膠態二氧化矽顆粒，20 wt% 固體，以原樣使用）及 Fuso PL-2（37 nm 平均直徑之繭狀膠態二氧化矽顆粒形成平均長度為 70 nm 的結合球體，20 wt% 固體，以原樣使用）。攪拌下，將每種類型之膠態二氧化矽顆粒以指定的 wt% 加入單獨的漿料中，並使用 KOH 將最終 pH 值調至 8。在攪拌下加入潔淨室級 H₂O₂（30% 溶液）以達到在最終漿液中 0.4 wt% 或 0.2 wt% 的 H₂O₂ 濃度。在拋光實驗中，所述漿料係在將 H₂O₂ 加入漿料中的當天使用。

表 1

本發明之漿料

漿料#	L-天冬胺 酸 (wt%)	己二酸 (wt%)	腺嘌呤 (wt%)	Kordek™ MLX (wt%)	研磨劑類 型 (wt%)	H ₂ O ₂ (wt%)	pH
PS-1	0.9	-----		-----	Fuso-PL-2L (1.5%)	0.4	8
PS-2	0.5	0.1	-	0.005	Fuso-PL-2L (3%)	0.2	8
PS-3	0.5	0.1	-	0.005	Fuso-PL-2L (1.5%)	0.2	8
PS-4	0.5	0.1	-	0.005	Fuso-PL-2L (0.3%)	0.2	8
PS-5	0.5	-	0.05	0.005	Fuso-PL-2L (3%)	0.2	8
PS-6	0.5	-	0.05	0.005	Fuso-PL-2L (1.5%)	0.2	8
PS-7	0.5	-	0.05	0.005	Fuso-PL-2L (0.3%)	0.2	8

表 2

比較漿料

漿料#	L-天冬胺 酸 (wt%)	己二酸 (wt%)	腺嘌呤 (wt%)	Kordek™ MLX (wt%)	研磨劑類 型 (wt%)	H ₂ O ₂ (wt%)	pH
CS-1	0.9	-----		-----	Fuso-PL-2 (1%)	0.4	8
CS-2	0.5	0.1		0.005	Fuso-PL-2 (3%)	0.2	8
CS-3	0.5	0.1		0.005	Fuso-PL-2 (1.5%)	0.2	8
CS-4	0.5	0.1		0.005	Fuso-PL-2 (0.3%)	0.2	8
CS-5	0.5		0.05	0.005	Fuso-PL-2 (3%)	0.2	8
CS-6	0.5		0.05	0.005	Fuso-PL-2 (1.5%)	0.2	8
CS-7	0.5		0.05	0.005	Fuso-PL-2 (0.3%)	0.2	8

實例 2

與 Co:TiN 選擇性有關之鈷拋光實驗

【0041】 用以上實例 1 中的表 1 及 2 中揭示之漿料進行以下鈷及 TiN 拋光實驗。

表 3

CMP 拋光及清潔條件

拋光工具	Applied MIRRA
拋光墊	IC1010 - 聚胺酯；肖氏 D（Shore D）硬度為 57，30 及 60 μm 平均直徑的閉孔型孔隙及圓形槽，深度、寬度及間距分別為 760、510 及 3,050 μm
調節器	Saesol 8031C1-170 μm 金剛石尺寸；40 μm 金剛石凸起及 310 μm 金剛石間距
工藝	2 PSI（13.8 kPa）、93/87 RPM、200 ml/min（下壓力，壓板轉速/拋光頭轉速、漿料流動速率）
CMP 後清潔	Synergy - ATMI PlanarClean™ 組成：乙醇胺（1 至 10 wt%）、氫氧化四甲基銨（1 至 10 wt%），pH 值>13.5 且稀釋度 1:20。
拋光時間	Co 晶圓：20 秒且 TiN 晶圓：30 秒（對 Co 及 TiN 設置不同的拋光時間係因為其去除速率及膜厚度不同且需要殘留足夠的 Co 膜以準確量測去除速率）
晶圓	自 Novati 獲得的 200 mm PVD 鈷晶圓（約 1700Å 厚）及自 Wafernet 獲得的 200mm TiN 晶圓（約 2000Å 厚）

【0042】 使拋光之晶圓穿過流動 ATMI PlanarClean 化學品之 DSS-200 Synergy™（OnTrak）雙面晶圓洗滌器，用來自 KLA Tencor 的 RS200 金屬膜厚度量測工具量測鈷及 TiN 的去除速率。拋光結果在表 4 中。

表 4

CMP 拋光結果

漿料#	PVD Co RR (Å/min)	SiN RR (Å/min)	選擇性 Co:TiN
PS-1	2357	76	31
PS-2	2391	870	3
PS-3	2261	67	34
PS-4	2306	42	55
PS-5	1754	612	3
PS-6	1808	43	42
PS-7	1972	41	48
CS-1	3192	1422	2
CS-2	2856	1902	2
CS-3	2754	1445	2
CS-4	2477	789	3
CS-5	2654	1591	2
CS-6	2638	1225	2
CS-7	2352	541	4

【0043】 除 PS-2 及 PS-5 外，結果表明，平均粒徑為 23nm 的本發明 CMP 漿料之 Co:TiN 去除速率選擇性值為 31 或更高。相比之下，平均粒徑為 37 nm 的比較漿料具有非常低的 Co:TiN 去除速率選擇性值，為 2 至 4。總的說來，相對於平均粒徑較大且呈繭狀顆粒形式，而不是如本發明 CMP 漿料一般呈球體的比較漿料，本發明之 CMP 漿料顯示出的 Co:TiN 選擇性明顯增加。

【發明申請專利範圍】

【第1項】一種化學機械拋光鈷之方法，其包括：

提供包括鈷及 TiN 之基板；

提供化學機械拋光組合物，所述組合物包括以下各物作為初始組分：

水；

氧化劑；

至少 0.1 wt% 量的天冬胺酸或其鹽；

0.3wt%至 2wt%的平均粒徑小於或等於 25 nm 的球形膠態二氧化矽研磨劑；及

腐蝕抑制劑，其中所述腐蝕抑制劑包括腺嘌呤；

視情況，殺生物劑；

視情況，pH 調節劑；

視情況，界面活性劑；

其中所述化學機械拋光組合物之 pH 值為 7 至 9；

提供具有拋光表面之化學機械拋光墊；

在所述化學機械拋光墊與所述基板之間的界面處建立動態接觸；且

將所述化學機械拋光組合物分配至在所述化學機械拋光墊與所述基板之間的界面處或附近的所述化學機械拋光墊之拋光表面以去除所述鈷之至少一部分。

【第2項】如申請專利範圍第 1 項所述的方法，其中在 200 mm 拋光機上，在壓板轉速為 93 轉/分鐘，拋光頭轉速為 87 轉/分鐘，化學機械拋光組物流動速率為 200 mL/min，標稱下壓力為 13.8 kPa 下，所提供的所述化學機械拋光組合物之鈷去除速率 $\geq 1500 \text{ \AA}/\text{min}$ ；且其中所述化學機械拋光墊包括含有聚合物空心微粒及聚胺酯浸漬之非編織襯墊的聚胺酯拋光層。

【第3項】如申請專利範圍第 1 項所述的方法，其中所提供的所述化學機械拋光組合物包括以下各物作為初始組分：

所述水；

所述氧化劑，其中所述氧化劑係過氧化氫；

0.1 wt%至 5 wt%的所述天冬胺酸或其鹽；

0.3wt%至 2wt%的所述球形膠態二氧化矽研磨劑，其中所述球形膠態二氧化矽研磨劑之平均粒徑為 5 nm 至 25 nm 並具有負 ζ 電位；及

所述腐蝕抑制劑；

視情況，所述殺生物劑；

視情況，所述界面活性劑；

視情況，所述 pH 調節劑；且

其中所述化學機械拋光組合物之 pH 值為 7 至 9。

【第4項】如申請專利範圍第 3 項所述的方法，其中在 200mm 拋光機上，在壓板轉速為 93 轉/分鐘，拋光頭轉速為 87 轉/分鐘，化學機械拋光組物流動速率為 200 mL/min，標稱下壓力為 13.8 kPa 下，所提供的所述化學機械拋光組合物之鈷去除速率 $\geq 1500 \text{ \AA}/\text{min}$ ；且其中所述化學機械拋光墊包括含有聚合物空心微粒及聚胺酯浸漬之非編織襯墊的聚胺酯拋光層。

【第5項】如申請專利範圍第 1 項所述的方法，其中所提供的所述化學機械拋光組合物包括以下各物作為初始組分：

所述水；

0.1 wt%至 2 wt%的所述氧化劑，其中所述氧化劑係過氧化氫；

0.1 wt%至 3 wt%的所述天冬胺酸或其鹽；

0.01 wt%至 1.5 wt%的所述球形膠態二氧化矽研磨劑，其平均粒徑為 10 nm 至 24 nm；及

所述腐蝕抑制劑；

視情況，所述殺生物劑；

視情況，所述 pH 調節劑；

視情況，所述界面活性劑；且

其中所述化學機械拋光組合物之 pH 值為 7 至 9。

【第6項】如申請專利範圍第 5 項所述的方法，其中在 200 mm 拋光機上，在壓板轉速為 93 轉/分鐘，拋光頭轉速為 87 轉/分鐘，化學機械拋光組物流動速率為 200 mL/min，標稱下壓力為 13.8 kPa 下，所提供的所述化學機械拋光組合物之鈷去除速率 $\geq 1500 \text{ \AA}/\text{min}$ ；且其中所述化學機械拋光墊包括含有聚合物空心微粒及聚胺酯浸漬之非編織襯墊的聚胺酯拋光層。

【第7項】如申請專利範圍第 1 項所述的方法，其中所提供的所述化學機械拋光組合物包括以下各物作為初始組分：

所述水；

0.1 wt%至 1 wt%的所述氧化劑，其中所述氧化劑係過氧化氫；

0.5 wt%至 1 wt%的所述天冬胺酸或其鹽；

0.3 wt%至 2 wt%的所述球形膠態二氧化矽研磨劑，其粒徑為 20 nm 至 23 nm；及

所述腐蝕抑制劑，其中所述腐蝕抑制劑包括非芳族多羧酸、其鹽或其混合物；

視情況，所述殺生物劑；

視情況，所述界面活性劑；

視情況，所述 pH 調節劑，其中所述 pH 調節劑係 KOH；且

其中所述化學機械拋光組合物之 pH 值為 7.5 至 9。

【第8項】如申請專利範圍第 7 項所述的方法，其中在 200 mm 拋光機上，

在壓板轉速為 93 轉/分鐘，拋光頭轉速為 87 轉/分鐘，化學機械拋光組合物流動速率為 200 mL/min，標稱下壓力為 13.8 kPa 下，所提供的所述化學機械拋光組合物之鈹去除速率 $\geq 1500 \text{ \AA}/\text{min}$ ；且其中所述化學機械拋光墊包括含有聚合物空心微粒及聚胺酯浸漬之非編織襯墊的聚胺酯拋光層。